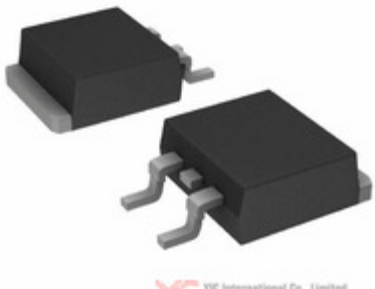









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB048N15N5LFATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 120A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB048N15N5LFATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB048N15N5LFATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 120A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.9V @ 255µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™-5
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	313W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB048N15N5LFATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 120A 313W (Tc) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A

IPB048N15N5LFATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB048N15N5LFATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB048N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB048N15N5LFATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB048N06LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO-263</p>	 <p>IPB049NE7N3 G Infineon Technologies IPB049NE7N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB044N15N5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPB049N06L3 G INFINEON IPB049N06L3 G INFINEON</p>
 <p>IPB049N06L3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB049N06L3G INF IPB049N06L3G INF</p>	 <p>IPB049N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB048N15N5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB048N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB048N15N5LFATMA1 Datenblatt	IPB048N15N5LFATMA1-Datenblätter	IPB048N15N5LFATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB048N15N5LFATMA1
IPB048N15N5LFATMA1 Electronic	IPB048N15N5LFATMA1-Komponenten	IPB048N15N5LFATMA1-Verteiler	IPB048N15N5LFATMA1-Bild	IPB048N15N5LFATMA1-Teil
IPB048N15N5LFATMA1 Preis	IPB048N15N5LFATMA1 Hersteller	IPB048N15N5LFATMA1 Bild	IPB048N15N5LFATMA1 Aktie	IPB048N15N5LFATMA1 Inventar
IPB048N15N5LFATMA1 Neu	IPB048N15N5LFATMA1 Original	IPB048N15N5LFATMA1 garantiert	IPB048N15N5LFATMA1 RFQ	IPB048N15N5LFATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited